

а 2004 0249

Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности к способам получения нанокompозитов.

Способ получения нанокompозита включает сенсibilизацию и каталитическую активацию поверхности предварительно полученной пористой структуры и последующее заполнение пор металлом. Сенсibilизацию и каталитическую активацию осуществляют в ультразвуковом поле. Пористая структура может быть выполнена из полупроводникового материала.

П. формулы: 1

Фиг.: 1